



АНТОВАНИЙ ЗВІТ
про виконану роботу у 2020 році в рамках реалізації проєкту
із виконання наукових досліджень і розробок

Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв'язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур

Назва конкурсу: Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

Реєстраційний номер Проєкту: 2020.02/0134

Підстава для реалізації Проєкту з виконання наукових досліджень і розробок (реєстраційний номер та назва Проєкту) 2020.02/0134 «Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв'язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур»

Рішення Наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця конкурсу **«Підтримка досліджень провідних та молодих учених»**
протокол від «16-17» вересня 2020 року № 21

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Тривалість виконання Проєкту

Початок – 02.11.2020 року дата укладання договору про виконання наукових досліджень і розробок;

Закінчення – 2022 рік

Загальна вартість Проєкту, грн. 4309546

Вартість Проєкту по роках, грн.:

1-й рік 617599

2-й рік 1 753677

3-й рік 1 938270

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТУ

до виконання Проєкту заличено 7 виконавців, з них:

доктори наук 2;

кандидати наук 1;

інші працівники 4.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ(Ї) СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

4. ОПИС ПРОЕКТУ

4.1. Мета Проекту

Проект спрямовано на розробку основних наукових засад і принципів керування оптичними і фотоелектричними властивостями тонких плівок на основі зв'язаних гібридів нанокластерів CdTe, CdSe, ZnCdTe і двовимірних наноструктур MoS₂ через встановлення закономірностей у перебігу процесу формування відгуку електронної підсистеми на оптичне збудження, пошук взаємозв'язку між морфологією, комплексною діелектричною проникністю, електропровідністю і ефективністю фотоелектричного перетворення.

4.2. Основні завдання Проекту

(1) Отримати гібридні наноструктуровані плівки на основі зв'язаних гібридів нанокластерів CdTe, CdSe, ZnCdTe і двовимірних наноструктур; з'ясувати особливості електронної будови та спектру енергетичних станів наноструктур, інтерфейсних та дефектних станів в залежності від компонентного складу, форми та розміру наноструктур, використовуючи прецизійні вимірювання фотопровідності, експериментальні дані з Фур'є-спектроскопії, спектроскопії поглинання/відбивання, фотопровідності, фотолюмінесценції, спектральної еліпсометрії та фотоелектричну діагностику.

(2) Оптимізувати геометрію та морфологію гібридних з'єднань квантова точка-дновимірна наноструктура на підкладках різного типу провідності та рівня легування, в тому числі гнучких, для створення умов найбільш ефективного поглинання світла та відповідного підвищення ефективності фотоелектричного перетворення.

(3) Розробити ефективний метод виготовлення тонких плівок, який би мінімізував оптичні та рекомбінаційні втрати у оптоелектронних пристроях: фотодетекторах та сонячних елементах наступного покоління.

4.3. Детальний зміст Проекту:

- Сучасний стан проблеми.

2D-структури є перспективними з огляду застосування їх в оптоелектроніці. Однією з важливих проблем залишається отримання простого і дешевого способу отримання 2D-об'єктів із заданими характеристиками на підкладках різного типу. Одним із перспективних способів є спін-коатінг із готових колоїдних розчинів нанооб'єктів із подальшим вивченням отриманих структур за допомогою мікроскопії, а також різного роду оптичними методами.

- Новизна Проекту.

Відпрацьовано техніку нанесення наноструктур MoS₂ на пластини Si та GaAs, скриті природним окислом. Досліджено оптичні константи моно- та кількашарових халькогенідів переходів металів, спектри комбінаційного розсіювання та фотолюмінесценції, отримано основні оптичні та зонні параметри зазначених 2D-наноструктур і порівняно їх із літературними даними. Встановлено, що параметри екситонів та їхніх комплексів мало змінюються при переході від моношару до кількашарової структури.

- Методологія дослідження.

Для оцінки морфології отриманих зразків застосовано атомно-силову і скануючу електронну мікроскопію. З метою дослідження оптичних параметрів наноструктур використано спектральну еліпсометрію, оптичну спектроскопію поглинання, комбінаційного розсіювання світла та фотолюмінесценції, а також температурні вимірювання люмінесцентних характеристик, моделювання оптичних констант.

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема:

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик)

Було проведено досліди з осадженням двовимірних (2D) структур на напівпровідників та діелектричні підкладки методом спін-коатінгу при різних режимах і подальшого відпалу при різних умовах. Відпрацьовано технологію нанесення флейків MoS₂ на вкриті природним окислом пластини кремнію та арсеніду галію з водних розчинів методом спін-коатінгу. Комплексні оптичні константи плівок MoS₂ виміряно за допомогою спектральної еліпсометрії та Стокс-поляриметрії. Визначено комплексні показники заломлення, коефіцієнт поглинання, а також розраховано оптичну провідність. Порівняння оптичних констант плівок, виготовлених на різних підкладках, з відповідними результатами об'ємних матеріалів виявляє відмінності внаслідок посилення електронно-діркових взаємодій у моношарах 2D-структур. Для остаточної ідентифікації отриманихnanoструктур і підтвердження їхніх морфологічних параметрів було досліджено і проаналізовано спектри фотолюмінесценції та раманівські спектри отриманих структур. Показано, що плівки виявляють очікувані оптичні властивості, типові для таких структур. Виявлено чіткі піки екситонного поглинання A і B в червоній області для всіх моношарових MoS₂ плівок. Показано, що їх природа пов'язана з електронними переходами у спін-орбітально розщеплених прямих зонах у точці K зони Бриллюена. На додачу до низькоенергетичних екситонних піків, в оптичних спектрах моношарів 2D-структур спостерігається серія різких піків з більшою енергією ($E > 2,5$ eВ). Сильна фотолюмінесценція в моношарах 2D-структур при кімнатній температурі обумовлена перетворенням непрямозонного об'ємного в прямоzonний напівпровідник в атомарно тонкому моношарі. Спектри мікро-фотолюмінесценції 2D-флейків MoS₂ показують дві широкі смуги, пов'язані з екситоном A, що перекривається з тріоном, і екситоном B, що спостерігається завдяки спін-орбітальному розщепленню валентної зони MoS₂. Розщеплення оцінене для флейків товщиною 2 та 10 моношарів як 130-137 мeВ при 290 К і незначно зменшується при пониженні температури. Виміри при різних температурах показують, що червоний зсув ФЛ при збільшенні температури і гасіння інтенсивності відбувається внаслідок термічно активованої безвипромінювальної рекомбінації зі збільшенням електрон-фононної взаємодії. Детальне вивчення температурної поведінки тріонної люмінесценції дозволило отримати енергію активації її теплового гасіння (~ 29 та ~ 18 мeВ для 2-шарових та 10-шарових структур, відповідно) та оцінити ефективний розмір тріона (~ 0.82 і ~ 0.75 нм відповідно). Всі параметри, оцінені для екситонів та тріону, узгоджуються із літературними даними для моношарового MoS₂. Зроблено висновок про те, що, незважаючи на зміщення смуг ФЛ екситона та тріона, інші оптичні характеристики не сильно змінюються з товщиною при переході від прямоzonного (одношарового) до непрямозонного кількашарового 2D-MoS₂. Нанорозмірні світловипромінювальні флейки мають потенціал застосування наноприладах, що працюють при низьких температурах із застосуванням зовнішньої модуляції оптичних властивостей. Результати оформлені у вигляді звіту і підготовлені до публікації в провідному фаховому журналі.

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з існуючими аналогами

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та суспільства (стосується проектів, що передбачають проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок)

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту в суспільній практиці.

Проектом передбачено створення та дослідження фундаментальних властивостей нового типу новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв'язаних гібридів квантових точок і двовимірних nanoструктур, здатних здійснювати різноманітні функції оптоелектронного перетворення, зокрема ефективну генерацію випромінювання та фотоелектричне перетворення

при одночасному забезпеченні вимог щодо малого енергоспоживання, високої надійності, високої швидкодії і низької вартості. Його виконання сприятиме підсиленню позитивного іміджу України як країни, яка підтримує фундаментальні дослідження у напівпровідниковій оптоелектроніці. Будуть отримані нові фундаментальні знання, які сприятимуть створенню конкуренто-спроможних технологій для отримання новітніх матеріалів з прогнозованими оптичними характеристиками та вдосконаленню оптоелектронних пристрій на їх основі. Результати виконання проекту будуть впроваджено в освітній процес, зокрема у лекційні курси «Основи наноелектроніки» та «Основи фотовольтаїки».

Науковий керівник Проекту

Професор кафедри оптики

Кондратенко Сергій Вікторович

(підпись)

